

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2305CDS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 5.8A SOT23-3</p>
	<p>Datenblätter:  SI2305CDS-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 257721 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI2305CDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 5.8A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	257721 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 5.8A (Tc) 960mW (Ta), 1.7W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	960mW (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 4.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2305CDS-T1-GE3CT

SI2305CDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2305CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2305CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2305CDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI2305DS SOT23 SI2305DS SOT23	 SI2305BDS-T1-GE3 VISHAY SI2305BDS-T1-GE3 VISHAY	 SI2305CDS-T1-E3 VISHAY SI2305CDS-T1-E3 VISHAY	 SI2305DS-E3-T1 VISHAY VISHAY SOT-23
 SI2305BDS-T1-E3 VISHAY SI2305BDS-T1-E3 VISHAY	 SI2305DS-T1 VISHAY SI2305DS-T1 VISHAY	 SI2305CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.8A SOT23-3	 SI2305DS-E3 VISHAY SI2305DS-E3 VISHAY

heiße Teile

Mehr

SI2303DS	SI2303DS-T1	SI2303DS-T1-E3	SI2303DS-T1-GE3	SI2304-TP
SI2304BDS-T1-E3	SI2304BDS-T1-E3	SI2304BDS-T1-GE3	SI2304BDS-T1-GE3	SI2304BDS-TI-E3
SI2304DDS-T1-E3	SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DS	SI2304DS-T1
SI2304DS-T1-E3	SI2304DS-T1-GE3	SI2305-CDS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-E3
SI2305ADS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-GE3	SI2305BDS-T1-E3	SI2305BDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-E3
SI2305CDS-T1-GE3	SI2305DS	SI2305DS-E3	SI2305DS-T1	SI2305DS-T1-E3
SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-GE3	SI2305WCB	SI2306BDS	SI2306BDS-T1
SI2306BDS-T1-E3	SI2306BDS-T1-E3	SI2306BDS-T1-GE3	SI2306BDS-T1-GE3	SI2306CDS-T1-E3
SI2306DS	SI2306DS-T1	SI2306DS-T1-E3	SI2306DS-T1-GE3	SI2306WCA
SI2307BDS	SI2307BDS-T1-E3	SI2307BDS-T1-E3	SI2307BDS-T1-GE3	SI2307BDS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited